



**第5回領域会議
おわりに**

感想

- 3期生が加わって、層が厚くなった。
 - 有機系のプロセスの方が増えた
 - 物理系とのコラボに期待
- 積極的な質問の姿勢がよかった。
 - 3期生もよく質問していた
- 分野を超えたディスカッションができた。
 - 特に、懇親会・2次会で非常に強い相互作用
- アドバイザとの交流がもっとあれば・・・

感想つづき

- 1・2期生に大きな進展が見られた。
 - 高橋有:ホイスラーで最高スピン偏極
 - 深田:Geナノワイヤのドーピング初確認
 - 竹中:Ge n-MOSFET on/off 最高値 10^5
 - 葛西:確率共鳴による応答高速化確認
 - 斎藤:誘電体スピン流伝導を世界で初めて検証
 - 白石:単層グラフェンの室温スピン注入を初確認
 - 浜屋:シリコンスピントロニクス室温動作確認
 - 小林:世界最高の熱整流比達成
 - 安田:延伸で1000倍以上の導電率向上確認
 - 山口:磁気渦の運動の制御の電氣的観察に成功
 - 福村:室温磁性半導体の電界による磁性制御成功

ここに紹介しなかった
方々も大きく進展しつつある
ことを確認→期待ふくらむ
・もっとアピールしてね。

CM:理科力をきたえるQ&A



- 絵と文: 佐藤勝昭
- 12月中旬配本予定

